

فصل ششم

تقویت کننده تفاضلی

(Differential Amplifier)

زمان اجرا : ۸ ساعت آموزشی

هدف کلی : بررسی و تحلیل مدارهای ساده تقویت کننده تفاضلی

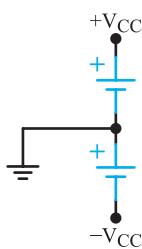
هدف های رفتاری : پس از پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می رود که :

- ۵- ضرب حذف سیگنال مشترک (CMRR) را شرح دهد.
- ۶- مسائل مربوط به تقویت کننده تفاضلی را حل کند.
- ۷- به سوال های الگوی پرسش پاسخ دهد.

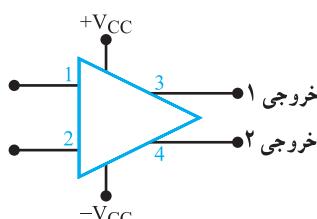
- ۱- نقشه فنی تقویت کننده تفاضلی را رسم کند.
- ۲- مدار تقویت کننده تفاضلی را از نظر DC تحلیل کند.
- ۳- مدار منبع جریان و نقش آن را در تقویت کننده تفاضلی شرح دهد.
- ۴- تقویت کننده تفاضلی را از نظر ac تحلیل کند.

۱-۶- نقشه فنی تقویت کننده تفاضلی

در شکل ۱-۶ نقشه فنی تقویت کننده تفاضلی نشان داده شده است. همان طور که می بینید، در این شکل دو ترمینال ورودی و دو ترمینال خروجی وجود دارد. به منظور استفاده از این تقویت کننده ها، ابتدا باید ارتباط این ترمینال ها را بدانیم تا بتوانیم تقویت کننده را به کار ببریم. به شکل ۱-۶ دقت کنید، در این شکل علاوه بر ترمینال های ورودی و خروجی، دو ترمینال دیگر نیز برای اتصال به خط تغذیه متقارن وجود دارد. چگونگی ایجاد خط تغذیه متقارن در شکل ۱-۶ نشان داده شده است.



شکل ۱-۶- چگونگی
ایجاد خط تغذیه متقارن



شکل ۱-۶- نقشه فنی
تقویت کننده تفاضلی

پیش گفتار

در تقویت کننده های معمولی مانند امیتر مشترک با انتخاب R_E نسبتاً بزرگ و بای پاس نمودن آن توسط خازن، می توان به ضرب تقویت کافی و پایداری حرارتی مناسب دست یافت. ولی به دلیل وجود خازن بای پاس، در این نوع تقویت کننده ها فرکانس های کم و سیگنال DC به درستی تقویت نمی شوند و ضرب تقویت کاهش می یابد.

برای تقویت سیگنال های با فرکانس پایین و DC از تقویت کننده تفاضلی یا دیفرانسیلی (differential amp) استفاده می کنیم. یکی دیگر از مشکلات تقویت کننده هایی که تاکنون آن ها را بررسی کرده ایم این است که توانایی تفکیک سیگنال از نویز را ندارند و هر دو را به یک اندازه تقویت می کنند. در صورتی که تقویت کننده تفاضلی دارای قابلیت تفکیک سیگنال از نویز است و می تواند هر کدام را با ضرب تقویت متفاوتی به خروجی مدار منتقل کند. در این فصل ساختمان و کاربرد تقویت کننده تفاضلی تشریح خواهد شد.

۳-۶- بررسی رفتار DC تقویت‌کننده تفاضلی

شکل ۳-۶ اساس مدار تقویت‌کننده تفاضلی را نشان می‌دهد که اجزا و قطعات هر دو نیمه از نظر تعداد و مقدار با هم برابر است یعنی، $R_{B1} = R_{B2}$ ، $R_{C1} = R_{C2}$ و $TR_1 = TR_2$. مقاومت امیتر R_E نیز در TR_1 و TR_2 مشترک است.

با فرض تقارن کامل دو نیمه، در حالی که هیچ سیگنال متناوبی در ورودی وجود نداشته باشد می‌توانیم بنویسیم.

$$I_{E1} = I_{E2} = \frac{I_E}{2}$$

چون β ترانزیستورها خیلی زیاد است، می‌توان از جریان بایاس بیس ترانزیستورها صرف نظر کرد در این صورت داریم:

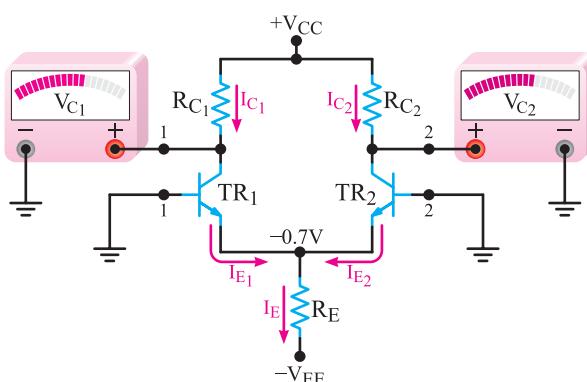
$$I_{C1} = I_{C2} = I_{E1} = I_{E2}$$

هم‌چنین با توجه به شرایط فرض شده می‌توانیم بنویسیم.

$$V_{C1} = V_{C2} = V_{CC} - R_{C1}I_{C1} = V_{CC} - R_{C2}I_{C2}$$

برای تجزیه و تحلیل بهتر مدار در حالت DC، ابتدا مطابق

شکل ۴-۶ هر دو ورودی را زمین می‌کنیم. به عبارت دیگر ولتاژ بیس ترانزیستورها را صفر در نظر می‌گیریم ($V_B = 0^\circ$). در این حالت ولتاژ امیتر ترانزیستور دارای پتانسیلی برابر با 7° -ولت است.



شکل ۴-۶- بیس ترانزیستورها زمین شده‌اند.

با فرض مشابه بودن هر دو نیمه، جریان امیتر هر دو ترانزیستور برابر است و از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$I_{E1} = I_{E2} = \frac{I_E}{2}$$

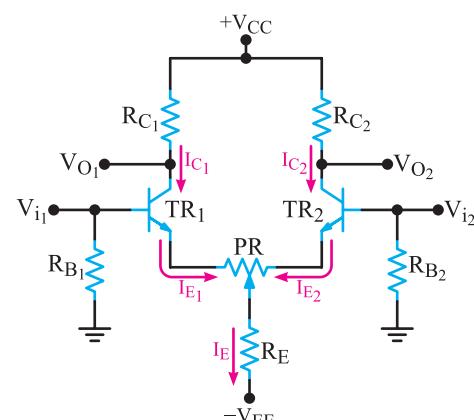
ولتاژهای ورودی را می‌توان به یک یا هر دو ترمینال ورودی اعمال کرد. ولتاژ خروجی نیز در هر دو ترمینال خروجی ظاهر می‌شود. البته از نظر زاویه فاز بین ترمینال‌های ورودی و خروجی پلاریته متفاوتی وجود دارد.

۳-۶- مدار تقویت‌کننده تفاضلی

نقشه ساده یک تقویت‌کننده تفاضلی (diff-amp) در شکل ۳-۶ رسم شده است. این مدار دارای دو ورودی V_{i1} و V_{i2} و دو خروجی، V_{O1} و V_{O2} است. ورودی‌ها به طور جداگانه به بیس ترانزیستورها متصل می‌شوند. از سوی دیگر، چون امیترها به مقاومت مشترکی اتصال دارند، خروجی‌های V_{O1} و V_{O2} به وسیله یک یا هر دو سیگنال ورودی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. خروجی‌ها، از کلکتور هر یک از ترانزیستورها قابل دریافت است. هم‌چنین دو منبع تغذیه برای مدار وجود دارد. ولتاژهای $+V_{CC}$ و $-V_{EE}$ به نقاط مورد نظر و سیم مشترک آن به زمین وصل شده است.

تحقیق کنید:

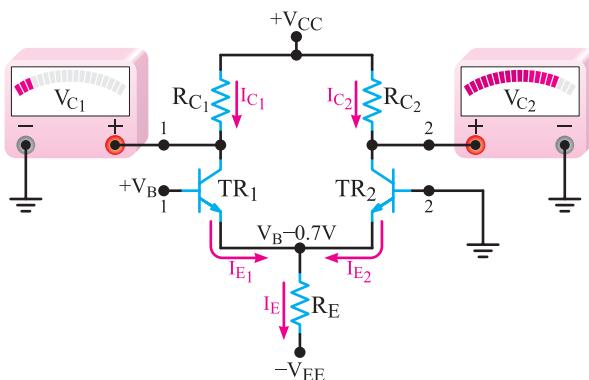
با توجه به آموخته‌های خود آیا در صورت داشتن مفروضات و معلومات موردنیاز، می‌توانید مجهولات را در مورد مدار شکل ۳-۶ به دست آورید. نتیجه تحقیق خود را به کلاس ارائه دهید.



شکل ۳-۶- مدار تقویت‌کننده تفاضلی

چ) کاهش I_{C2} ، V_{C2} را افزایش می‌دهد.
پس نتیجه می‌گیریم با زیاد شدن V_{B1} ، مقدار V_{C1} کم شده و V_{C2} زیاد می‌شود.

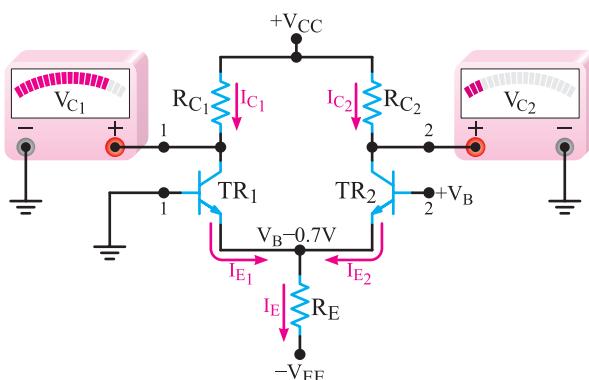
به عبارت دیگر بین خروجی‌های V_{C1} و V_{C2} اختلاف فازی برابر با 180° وجود دارد.



شکل ۶-۶- تغییرات ولتاژ و جریان مدار در اثر اتصال ولتاژ به بیس TR

در صورتی که ورودی (۱) را مطابق شکل ۶-۷ زمین کنم و به ورودی (۲) ولتاژ بایاس مثبتی اعمال نمایم. هدایت ترازیستور TR_2 زیاد می‌شود و I_{C2} افزایش می‌یابد و در نهایت V_{C2} کم می‌شود.

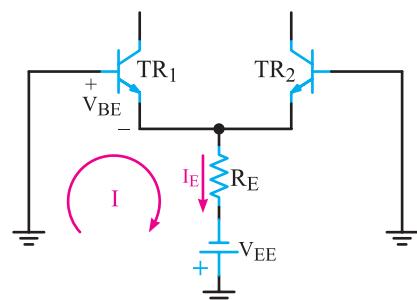
در این حالت وضعیت تغییرات ایجاد شده در مدار عکس تغییرات حالت قبل است.



شکل ۶-۷- تأثیر بایاس بیس TR_2 روی جریان و ولتاژ مدار

همان طوری که شکل ۶-۷ نشان می‌دهد، هدایت TR_2 سبب کاهش هدایت TR_1 می‌شود و I_{C1} را کاهش می‌دهد و

با نوشتен معادله KVL در حلقه نشان داده شده در شکل ۶-۵ می‌توانیم مقدار I_E را محاسبه کنیم.



شکل ۶-۵- معادله KVL در حلقه I

$$+V_{BE} + R_E I_E - V_{EE} = 0$$

$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E}$$

با توجه به شرایط مدار داریم :

$$I_{C1} = I_{C2} = I_{E1} = I_{E2} = \frac{I_E}{2}$$

مقدار ولتاژ کلکتور ترازیستورها را محاسبه می‌کنیم.

$$V_{C1} = V_{C2} = V_{CC} - R_{C1} I_{C1} = V_{CC} - R_{C1} \frac{I_E}{2}$$

چنانچه مطابق شکل ۶-۶ به ورودی (۱) ولتاژ بایاس

مبتدی بدھیم و ورودی (۲) را زمین کنیم، ولتاژ بایاس بیس T_{R1} سبب افزایش هدایت T_{R1} می‌شود و I_{C1} را زیاد می‌کند، با زیاد شدن I_{C1} مقدار V_{C1} کاهش می‌یابد. در این حالت ولتاژ امیتر ترازیستورها از رابطه زیر به دست می‌آید :

$$V_E = V_B - V_{BE} = V_B - 0.7V$$

با اعمال ولتاژ $+V_{B1}$ فرآیند زیر اتفاق می‌افتد.

(الف) با زیاد شدن V_{B1} ، I_{B1} زیاد می‌شود.

(ب) با زیاد شدن I_{B1} ، I_{C1} و I_{E1} زیاد می‌شود.

(پ) با زیاد شدن V_E ، مقدار I_E زیاد می‌شود.

(ت) با زیاد شدن V_E مقدار ولتاژ بایاس بیس امیتر TR_2 (V_{BE2}) کم می‌شود.

(ث) با کم شدن V_{BE2} مقدار I_{B2} کاهش می‌یابد.

(ج) با کاهش I_{B2} ، I_{C2} کم می‌شود.

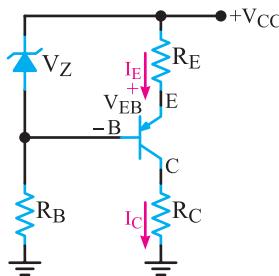
۶-۶- مدار منبع جریان

منبع جریان مداری است که در آن جریان خروجی به مقاومت بار بستگی ندارد و تحت شرایطی، جریان بار همواره ثابت است.

در شکل ۶-۱۰ مدار یک منبع جریان ساده ترانزیستوری نشان داده شده است. ولتاژ دو سر مقاومت R_E از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$V_{RE} = R_E I_E = V_Z - V_{EB}$$

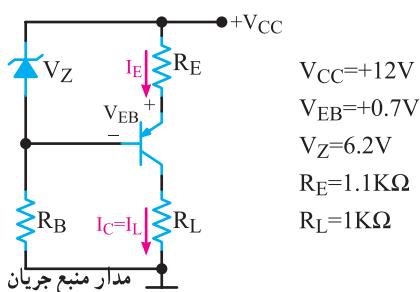
در این رابطه چون مقادیر V_{EB} ، R_E و V_Z تقریباً ثابت‌اند، I_E نیز در محدوده معینی از R_L تقریباً ثابت باقی می‌ماند. از طرفی چون جریان کلکتور ترانزیستور تقریباً با جریان I_E برابر است، لذا I_C نیز ثابت می‌شود.



شکل ۶-۱۰- مدار منبع جریان ساده ترانزیستوری

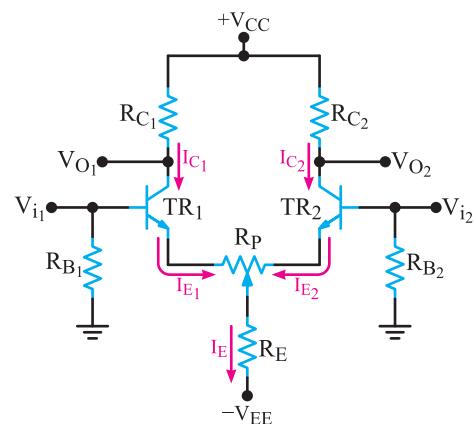
مانند هر پدیده دیگر، منبع جریان محدودیت دارد، عناصر مدار و حدود ولتاژ ورودی، شرایط مدار را تعیین می‌کند. به عنوان مثال یک منبع جریان می‌تواند جریان را روی ۱۰۰ میلی‌آمپر ثابت نگهدارد، در صورتی که مقدار بار بین $R_L = 1\text{K}\Omega$ تا $R_L = 10\text{K}\Omega$ باشد.

مثال ۶-۱: جریان بار را در شکل ۱۱-۶ محاسبه کنید.



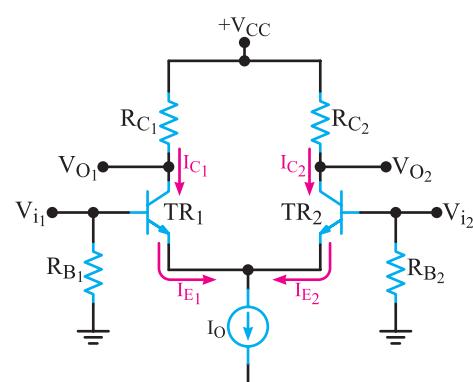
شکل ۱۱-۶

در نهایت V_{CE} افزایش می‌یابد. با فرض تقارن بین دو طبقه و مشابه بودن قطعات مدار، تغییرات I_{C1} و I_{C2} و V_{CE} کاملاً هم اندازه خواهند بود. به دلیل اختلاف ذاتی موجود در hfe ترانزیستورها، عدم تقارن بین دو قسمت مدار به وجود می‌آید. می‌توان مانند شکل ۶-۸، پتانسیومتری را در مدار قرار داد و با تغییر R_P مدار را به حالت تعادل درآورد.



شکل ۶-۶- مدار تقویت‌کننده تفاضلی با پتانسیومتر متعادل کننده

در بعضی از مدارها به جای مقاومت R_E از یک منبع جریان طبق شکل ۶-۹ استفاده می‌شود.



شکل ۶-۹- تقویت‌کننده تفاضلی با منبع جریان

در این حالت، مقدار $I_O = I_{E1} + I_{E2}$ و برابر با مقدار ثابتی است. به دلیل وجود منبع جریان I_O ، در صورت افزایش I_{E1} ، جریان I_{E2} کاهش و با کاهش I_{E1} جریان I_{E2} افزایش می‌یابد.

پاسخ:
محاسبه I_E هر ترانزیستور

$$I_O = 1.0 \text{ mA}$$

$$I_{E1} + I_{E2} = I_O = 1.0 \text{ mA}$$

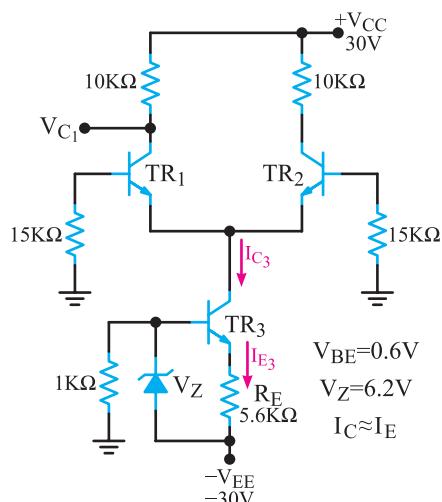
$$I_{E1} = I_{E2} = \frac{I_O}{2} = 0.5 \text{ mA}$$

محاسبه V_C

$$V_{C1} = V_{C2} = V_{CC} - R_C I_C$$

$$V_{C1} = V_{C2} = 20 - (1)(0.5) = 15 \text{ V}$$

مثال ۱۳-۶: در شکل ۱۳-۶ به شرط تقارن دو نیمه V_{C1} را محاسبه کنید.



شکل ۱۳-۶- تقویت کننده تفاضلی با منبع جریان

پاسخ: محاسبه جریان منبع جریان

$$I_{E2} = \frac{V_Z - V_{BE}}{R_E}$$

$$I_{E2} = \frac{6.2 - 0.6}{5/6K} = 1 \text{ mA}$$

$$I_{C2} = I_{E2} = 1 \text{ mA}$$

محاسبه جریان کلکتور ترانزیستورهای TR₁ و TR₂

$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{I_{C2}}{2}$$

$$I_{C1} = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ mA}$$

پاسخ:
محاسبه I_E

$$V_Z = R_E I_E + V_{EB}$$

$$I_E = \frac{V_Z - V_{EB}}{R_E} = \frac{6/2 - 0.6}{1/1} = 4.8 \text{ mA}$$

$$I_E = \frac{0.5}{0.1} = 5 \text{ mA}$$

محاسبه I_L

$$I_C \approx I_E = 5 \text{ mA}$$

$$I_L = 5 \text{ mA}$$

تحقیق کنید: آیا در مجموعه قطعات الکترونیکی موجود

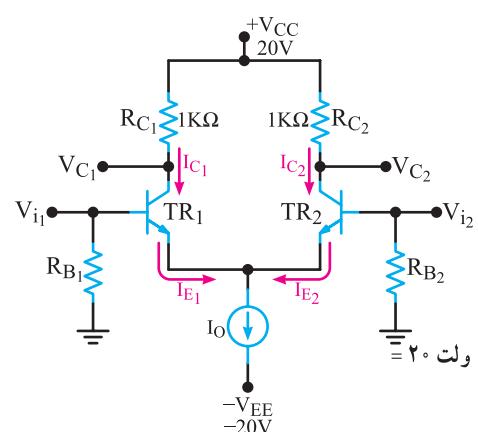
در بازار، یک تقویت کننده تفاضلی به صورت مدار مجتمع وجود دارد؟ با مراجعه به اینترنت، موضوع را بررسی و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

کمی فکر کنید: تقویت کننده تفاضلی با مقاومت R_E

در مقایسه با منبع جریان چه تفاوتی دارد؟ کدام یک نسبت به دیگری برتری دارد؟ با دوستان خود بحث کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

مثال ۱۲-۶: در شکل ۱۲-۶ اگر جریان منبع جریان

۱.۰ باشد، به شرط تقارن دو نیمه V_{C1} چه قدر است؟



شکل ۱۲-۶- تقویت کننده تفاضلی با منبع جریان

محاسباتی

۱۵-۶- در شکل ۱۵-۶ جریان I_E و ولتاژهای V_{CE1} و

V_{CE2} را محاسبه کنید. از I_B ترازیستورها صرفنظر کنید.

$$V_{BE\downarrow} = V_{BE\uparrow} = \circ / \nabla V \quad \beta_\downarrow = \beta_\uparrow = 1 \circ$$

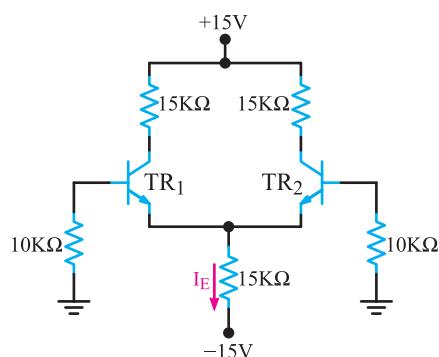
$$I_{C1} \approx I_{E1} \quad , \quad I_{C2} \approx I_{E2}$$

محاسبة V_{C1}

$$V_C = V_{CC} - R_C I_C$$

$$V_{C_1} = 30 - (10)(\frac{1}{5}) = 25 \text{ ولت}$$

بحث کنید: آیا با استفاده از دو ترانزیستور معمولی، می‌توان تقویت کننده تفاضلی طراحی کرد؟ در صورتی که جواب مثبت است، چه نوع ترانزیستوری مناسب است؟ NPN یا PNP؟



شکل ۱۵-۶

۵-۶-۱۶ در شکل ۶-۱۶ حیان I_E و V_{CE} را محاسبه

کنید۔

(ترانزیستورها مشابه‌اند)

$$\beta = \gamma \circ \circ \quad V_z = \lambda V \quad V_{BE} = \circ / \lambda V$$

۵۔ الگوی پرسش کامل کردنی

۱-۵-۶- تقویت کننده تفاضلی می‌تواند سیگنال‌های با نکانس، و را تقویت کند.

صحیح یا غلط

۲_۵_۶ - تقویت کننده تفاضلی نمی‌تواند سیگنال را از و ب تفکیک کند.

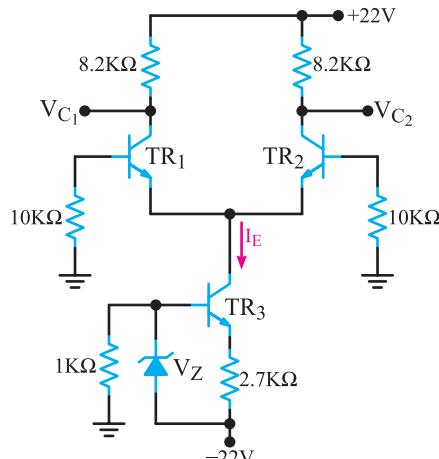
حصار گزنه ای

۳-۵-۶-د، مدار شکا، ۱۴-۶ مقدار I حند میله آمر

ست؟ $V_{BE} = 0$ / V از I_B صرف نظر کنید.

(۱) ۱۳/۳ (۲)

۱۵۳

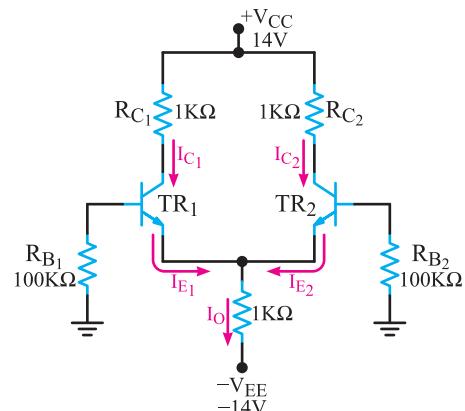


شکا ۱۶

۶_۵_۶_اگر در مدار شکل ۷_۶ به بیس، TR، ولتاژ

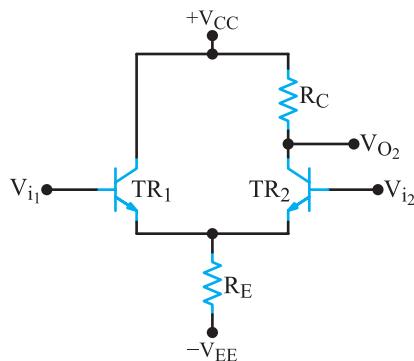
مبتنی بدھیم، فرآیند تغییر جریان و ولتاژ کلکتور ترانزیستورها را شرح دید.

شرح دهید.



شکا ۱۴

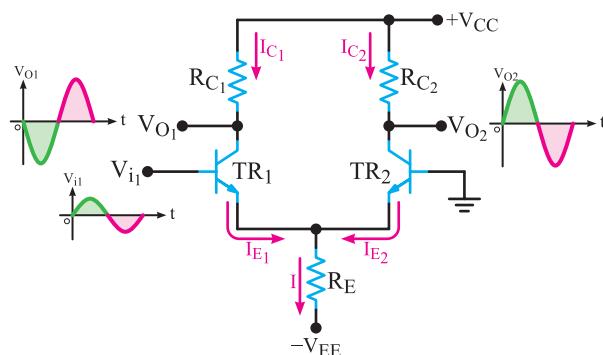
ت) دو ورودی، یک خروجی (شکل ۶-۲۰).



شکل ۶-۲۰- تقویت کننده تفاضلی با دو ورودی و یک خروجی

اگر نون به تشریح عملکرد سه حالت پرکاربرد این مدار می پردازیم.

۶-۶-۱- تقویت کننده تفاضلی با یک ورودی و دو خروجی (Single Ended Differential Input) : در شکل ۶-۲۱ مدار یک تقویت کننده تفاضلی با یک ورودی و دو خروجی نشان داده شده است.



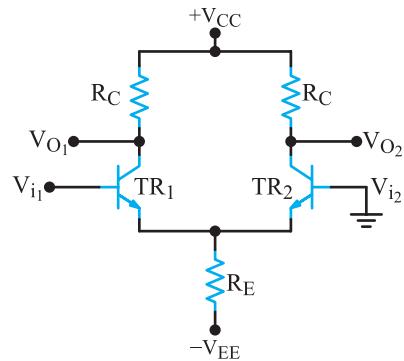
شکل ۶-۲۱- مدار تقویت کننده تفاضلی با یک ورودی و دو خروجی

در این مدار، سیگنال V_{i1} به بیس ترانزیستور TR₁ اعمال می شود. همچنین بیس ترانزیستور TR₂ به زمین وصل شده است. سیگنال اعمال شده به بیس TR₁، هدایت این ترانزیستور را کنترل می کند. در نتیجه، جریان I_{C1} و I_{E1} متناسب با سیگنال ورودی تغییر می کند. از طرفی چون خروجی (۱) از کلکتور TR₁ دریافت شده است، TR₁ به صورت امیتر مشترک عمل می کند. بنابراین سیگنال خروجی TR₁ تقویت شده سیگنال بیس TR₁ است و خروجی V_{O1} با سیگنال V_{i1} درجه اختلاف ۱۸۰° دارد.

۶-۶- بررسی رفتار AC تقویت کننده تفاضلی

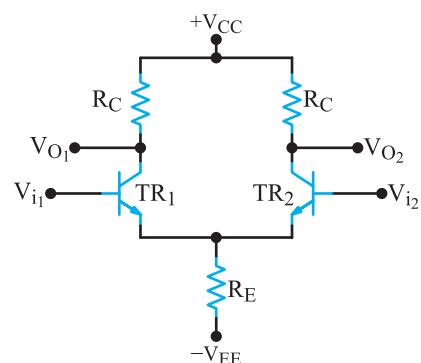
یک تقویت کننده تفاضلی ممکن است در چهار حالت مورد استفاده قرار گیرد:

الف) یک ورودی، دو خروجی؛ شکل ۶-۱۷ این حالت را نشان می دهد.



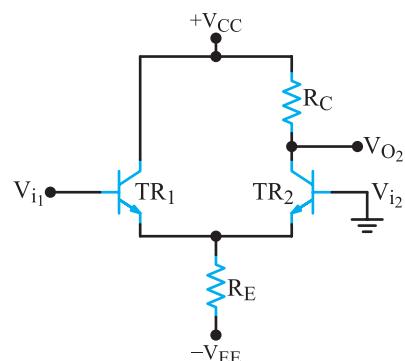
شکل ۶-۱۷- تقویت کننده تفاضلی با یک ورودی و دو خروجی

ب) دو ورودی، دو خروجی؛ (شکل ۶-۱۸)

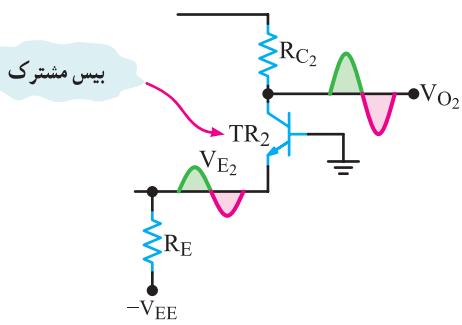


شکل ۶-۱۸- تقویت کننده تفاضلی با دو ورودی و دو خروجی

پ) یک ورودی، یک خروجی؛ در شکل ۶-۱۹ این حالت را مشاهده می کنید.

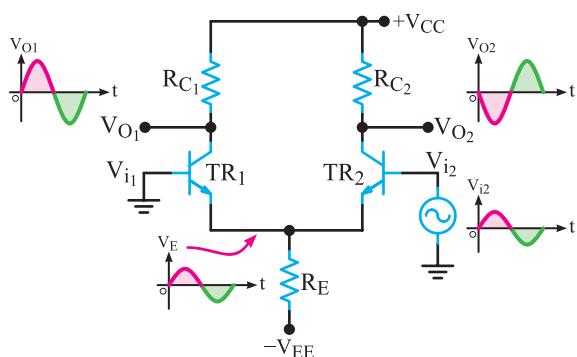


شکل ۶-۱۹- تقویت کننده تفاضلی با یک ورودی و یک خروجی



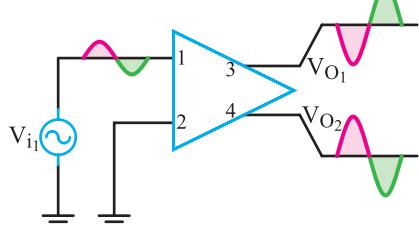
شکل ۶-۲۳—شکل موج ورودی و خروجی_۲

بنابر آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که با اتصال کوتاه بیس_۱ TR_۱ به زمین و اعمال سیگنال ورودی به بیس_۲ TR_۲، سیگنال خروجی (V_{O_۲}) با سیگنال ورودی ۱۸° اختلاف فاز دارد ولی سیگنال خروجی V_{O_۱} با ورودی هم فاز است. شکل ۶-۲۴ این حالت اتصال مدار و شکل موج‌های ورودی و خروجی مدار را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۲۴—اتصال سیگنال به بیس_۲ TR_۲

در شکل‌های ۶-۲۵ و ۶-۲۶ تقویت‌کننده تفاضلی به صورت نقشه بلوکی در حالت یک ورودی و دو خروجی و شکل موج‌های ورودی و خروجی آن رسم شده است.



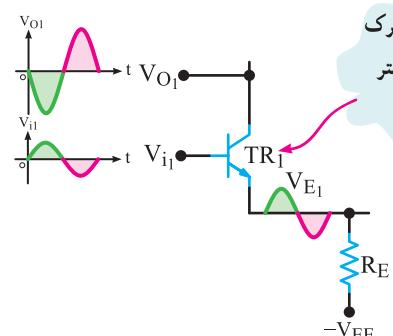
شکل ۶-۲۵—نقشه بلوکی تقویت‌کننده تفاضلی با یک ورودی و دو خروجی

فاز دارد. همان طور که قبلاً گفتیم، سیگنال ورودی (V_{i_۱}) مقدار I_{C_۱} و I_{E_۱} را تغییر می‌دهد. هم‌چنین به دلیل ثابت بودن جریان I_{E_۱} که مساوی مجموع دو جریان I_{E_۱} و I_{E_۲} است، با تغییر I_{E_۱} به ناچار I_{E_۲} نیز تغییر خواهد کرد. مثلاً اگر I_{E_۱} افزایش یابد به همان اندازه I_{E_۲} کاهش می‌یابد. یعنی تغییرات جریان در TR_۱ به ترانزیستور TR_۲ انتقال می‌یابد و عمل تغییرات V_{B_۱} روی جریان I_{C_۲} اثر می‌گذارد.

تأثیر سیگنال ورودی (V_{B_۱}) روی ترانزیستور TR_۲ را می‌توان به طریق دیگری نیز تشریح نمود. با توجه به شکل ۶-۲۱ سیگنال بیس_۱ TR_۱ بدون تغییر فاز و تقریباً هم دامنه با ورودی روی امیتر TR_۱ و TR_۲ ظاهر می‌شود. چون بیس TR_۲ به زمین وصل شده است، سیگنال روی امیتر TR_۲ به عنوان ورودی عمل می‌کند. از طرفی چون خروجی V_{O_۲} را از کلکتور TR_۲ دریافت می‌کیم، این ترانزیستور حالت بیس مشترک را به خود می‌گیرد.

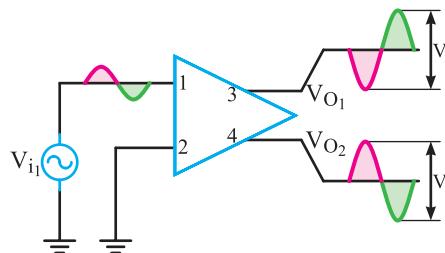
لذا سیگنال خروجی V_{O_۲} با سیگنال Vi_۱ هم فاز می‌باشد. بدین ترتیب، در خروجی TR_۲ سیگنالی هم فاز و در خروجی TR_۱ سیگنال با ۱۸° درجه اختلاف فاز با ورودی TR_۱ خواهیم داشت. در واقع، اگر سیگنال ورودی را به بیس هر یک از ترانزیستورها اعمال کنیم، تقویت‌شده آن را در خروجی خودش با ۱۸° درجه اختلاف فاز و در خروجی ترانزیستور دیگر به صورت هم فاز دریافت خواهیم کرد.

در شکل‌های ۶-۲۲ و ۶-۲۳ سیگنال ورودی و خروجی ترانزیستورها و نوع آرایش آن‌ها نشان داده شده است.



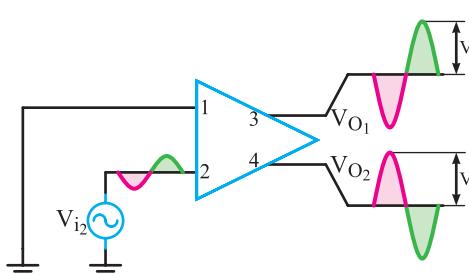
شکل ۶-۲۲—شکل موج ورودی و خروجی_۱ TR

عملکرد مدار را می‌توان به روش جمع آثار بررسی کرد؛ یعنی فرض کرد که به هر ورودی به طور جداگانه سیگنال اعمال شده است و به ازای آن ورودی، خروجی‌ها را در نظر گرفت. در شکل ۶-۲۹ خروجی‌ها به ازای $V_{i_1} = V_i$ و $V_{i_2} = 0$ داده شده‌اند. در این حالت، دامنه سیگنال‌های خروجی V_{O_1} و V_{O_2} مساوی V فرض شده است.



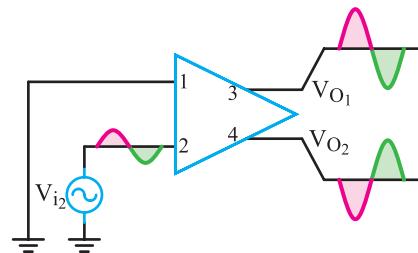
شکل ۶-۲۹—سیگنال به ورودی (۱) اعمال شده است.

در شکل ۶-۳۰ ورودی (۱) زمین شده و سیگنال به ورودی (۲) داده می‌شود. در این حالت چون دامنه سیگنال ورودی مشابه شکل ۶-۲۹ در نظر گرفته شده است. لذا دامنه سیگنال تقویت شده خروجی نیز مشابه مرحله قبل برابر با V می‌شود.



شکل ۶-۳۰—سیگنال به ورودی (۲) اعمال شده است.

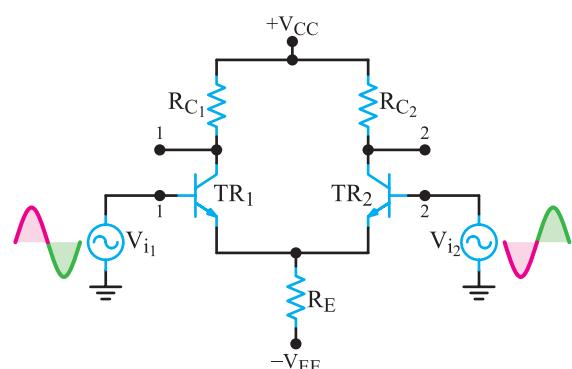
در صورتی که طبق شکل ۶-۳۱ ورودی‌های V_{i_1} و V_{i_2} با دامنه برابر و فاز مخالف به تقویت‌کننده تفاضلی اعمال گردند، سیگنال‌های خروجی مربوطه به دو ورودی با یکدیگر جمع می‌شوند و خروجی‌های V_{O_1} و V_{O_2} دو سیگنال با فاز مخالف نسبت به هم و دامنه مشخص مثلاً $2V$ دریافت خواهد شد که این حالت را حالت تفاضلی می‌نامند. مقدار دامنه خروجی‌ها بستگی به مقدار دامنه سیگنال‌های ورودی دارد.



شکل ۶-۲۶—نقشه بلوکی تقویت‌کننده تفاضلی با یک ورودی و دو خروجی

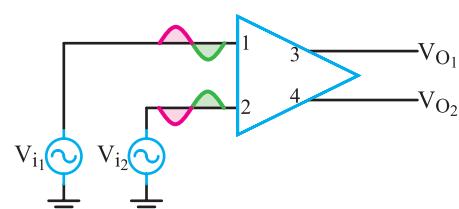
از مدار تقویت‌کننده تفاضلی با یک ورودی و دو خروجی می‌توان به عنوان مدار جداگانه فاز استفاده کرد.

۶-۶-۲ تقویت‌کننده تفاضلی با دو ورودی و دو خروجی با عملکرد ورودی تفاضلی (Double – Ended Differential Inputs) : کاربرد معمول حالت دو ورودی وقتی است که دو سیگنال ورودی در فاز مخالف نسبت به هم و با دامنه مساوی باشند. در شکل ۶-۲۷ چنین مداری را مشاهده می‌کنید.



شکل ۶-۲۷—تقویت‌کننده با ورودی تفاضلی

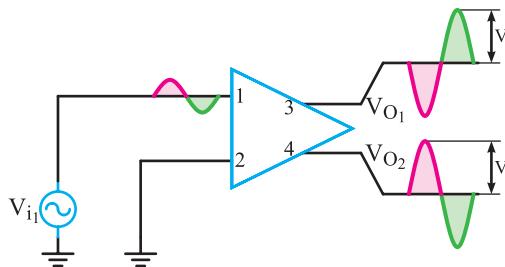
در شکل ۶-۲۸ تقویت‌کننده با ورودی تفاضلی و با استفاده از نقشه بلوکی تقویت‌کننده نشان داده شده است.



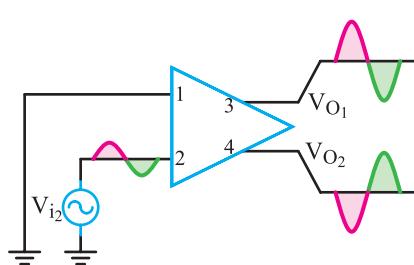
شکل ۶-۲۸—تقویت‌کننده با ورودی تفاضلی

اکنون باید دید که چگونه هر یک از ورودی‌ها، خروجی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند و شکل موج خروجی‌ها چگونه است.

سیگنال‌های V_{O1} و V_{O2} هر یک جمع دو سیگنال قرینه است. که هر یک در اثر ولتاژهای V_{i1} و V_{i2} حاصل می‌شود لذا V_{O1} و V_{O2} مساوی صفر می‌شود. در شکل ۶-۳۴ و ۶-۳۵ شکل موج‌های خروجی تقویت‌کننده به ازای هر ورودی به تفکیک رسم شده است.



شکل ۶-۳۴- شکل موج خروجی‌ها به ازای ورودی (۱)



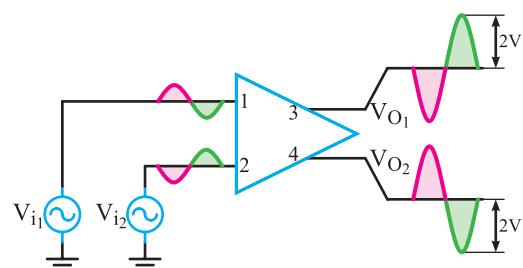
شکل ۶-۳۵- شکل موج خروجی‌ها به ازای ورودی (۲)

حالت سیگنال مشترک یکی از موارد کاربردی و محاسن تقویت‌کننده دیفرانسیلی به شمار می‌آید؛ زیرا سیگنال‌های مشترکی که به وسیله پارازیت، تغییرات ولتاژ منبع تعذیه و درجه حرارت پدید می‌آیند و تغییراتشان در هر دو ترانزیستور یکی است، کاملاً حذف می‌شوند.

۶-۷ ضریب حذف سیگنال مشترک Common Mode Rejection Ratio

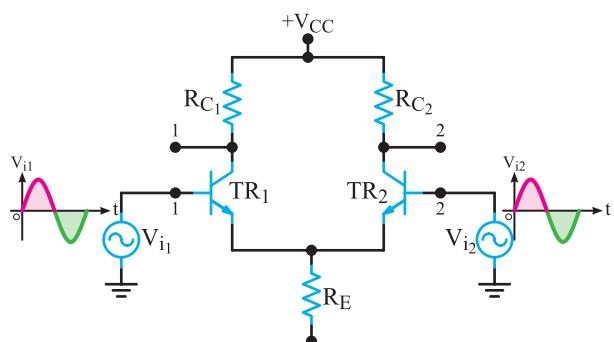
در یک تقویت‌کننده تفاضلی سیگنالی را که می‌خواهیم تقویت کنیم به یک ورودی، یا به صورت تفاضلی به دو ورودی اعمال می‌کنیم. این سیگنال مطابق آنچه که شرح داده شد، پس از تقویت در خروجی‌ها ظاهر می‌شود.

طبعی است سیگنال ناخواسته (نویز یا پارازیت) روی خط‌های ورودی با قطب‌های یکسان می‌نشیند. در این حالت



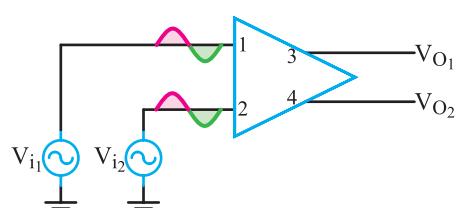
شکل ۶-۳۱- تقویت‌کننده تفاضلی با عملکرد ورودی تفاضلی

مشترک (Common Mode Inputs): یکی از مهم‌ترین کاربرد تقویت‌کننده تفاضلی حالت سیگنال مشترک است. در این حالت دو سیگنال با فاز، دامنه و فرکانس مساوی به دو ورودی تقویت‌کننده داده می‌شود. شکل ۶-۳۲ مدار تقویت‌کننده تفاضلی را در این حالت نشان می‌دهند.



شکل ۶-۳۲- تقویت‌کننده تفاضلی در حالت سیگنال مشترک

در شکل ۶-۳۳ تقویت‌کننده تفاضلی با استفاده از نقشه بلوکی در حالت سیگنال مشترک رسم شده است.



شکل ۶-۳۳- تقویت‌کننده تفاضلی در حالت سیگنال مشترک

در این حالت نیز اگر سیگنال‌های خروجی مربوط به هر ورودی را به روش جمع آثار رسم کنیم؛ مشاهده خواهیم کرد که

$$CMRR(\text{dB}) = 20 \log 10000 = 80$$

CMRR برابر ۱۰۰۰۰ به این مفهوم است که سیگنال ورودی مشخص به اندازه ۱۰۰۰۰ مرتبه بیشتر از سیگنال ناخواسته (نویز) که به صورت مُد مشترک به مدار وارد شده است، تقویت می‌شود. به عبارت دیگر اگر دامنه سیگنال خواسته شده در حالت تفاضلی و سیگنال ناخواسته نویز در حالت مُد مشترک یکسان باشند، سیگنال تعریف شده ۱۰۰۰۰ برابر بزرگ‌تر از دامنه نویز در خروجی ظاهر می‌شود.

تمرین کلاسی: در مثال ۶-۴ در حالتی که بهرهٔ حالت تفاضلی ۱۴۰۰ و بهرهٔ حالت مُد مشترک ۱/۱۵ باشد، مقدار CMRR را بر حسب دسی‌بل محاسبه کنید.

۸-۶_ الگوی پرسش صحیح یا غلط

۱-۶-۸-۱_ یک تقویت‌کننده تفاضلی، در حالت تفاضلی باید دارای بهرهٔ بسیار زیاد و در حالت سیگنال مشترک، بهرهٔ بسیار کم حدود صفر باشد.

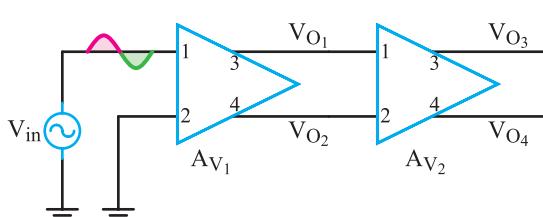
صحیح غلط

کوتاه پاسخ

۲-۶-۸-۲_ رابطهٔ ضریب حذف سیگنال مشترک (CMRR) را بنویسید.

چهار گزینه‌ای

۳-۶-۸-۳_ با توجه به V_{in} در مدار شکل ۶-۳۶، کدام است؟



شکل ۶-۳۶

تقویت‌کننده تفاضلی برای نویز در حالت سیگنال مشترک (Common Mode) عمل می‌کند و نویز را در خروجی حذف می‌نماید.

یک تقویت‌کننده تفاضلی ایده‌آل در شرایط مختلف باید دارای ویژگی‌های زیر باشد :

- در حالت یک ورودی (یکی از ورودی‌ها زمین می‌شود)، بهرهٔ زیاد

- در حالت تفاضلی (دو سیگنال با دامنه مساوی و فاز مخالف)، بهرهٔ زیاد

- در حالت سیگنال مشترک (دو سیگنال با دامنه و فاز برابر)، بهرهٔ صفر

در عمل معمولاً بهرهٔ تفاضلی عددی در حدود چند هزار و در حالت مُد مشترک خیلی کم‌تر از (۱) است. نسبت بهرهٔ حالت تفاضلی ($A_v(d)$ به بهرهٔ حالت مُد مشترک (A_{cm}) را ضریب حذف سیگنال مشترک یا CMRR می‌نامند.

$$CMRR = \frac{A_{vd}}{A_{cm}}$$

اغلب CMRR بر حسب دسی‌بل نیز بیان می‌شود

$$CMRR(\text{dB}) = 20 \log \frac{A_{vd}}{A_{cm}}$$

هر قدر عدد CMRR بزرگ‌تر باشد بهرهٔ حالت تفاضلی (A_{vd}) بیش‌تر و بهرهٔ حالت مُد مشترک (A_{cm}) کم‌تر است در این شرایط تقویت‌کننده تفاضلی به حالت ایده‌آل نزدیک‌تر می‌شود.

مثال ۶-۶: در یک تقویت‌کننده تفاضلی بهرهٔ حالت تفاضلی ۲۰۰۰ و بهرهٔ در حالت مُد مشترک ۱/۲٪ است. مقدار CMRR را محاسبه کنید. CMRR بر حسب دسی‌بل چه قدر است؟ مفهوم عدد بدست آمده چیست؟ شرح دهید.

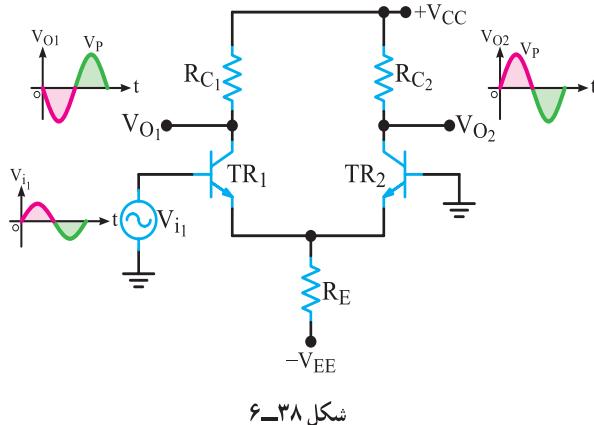
پاسخ :

$$A_{vd} = 2000$$

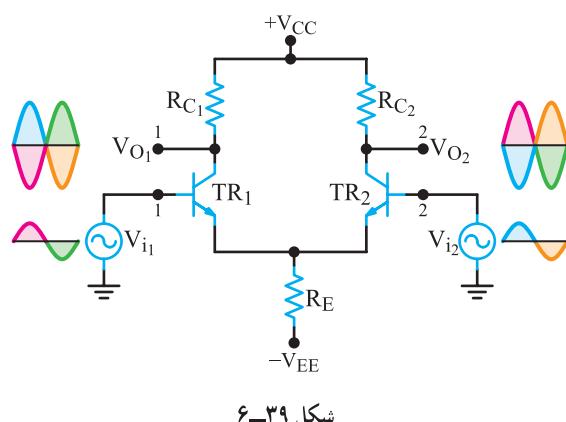
$$A_{cm} = 1/2$$

$$CMRR = \frac{A_{vd}}{A_{cm}} = \frac{2000}{1/2} = 10000$$

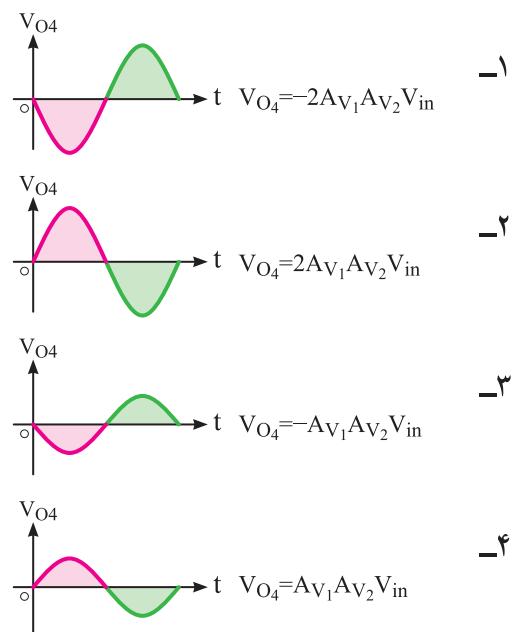
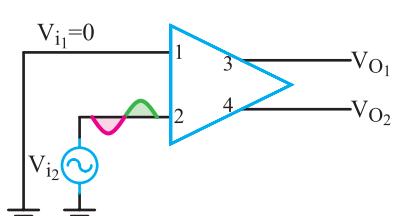
چه حالتی به کار رفته است؟ آرایش TR_1 و TR_2 از نظر سیگنال ورودی چگونه است؟



۶-۸-۷ در شکل ۶-۳۹ تقویت کننده تفاضلی در چه حالتی مورد استفاده قرار گرفته است؟

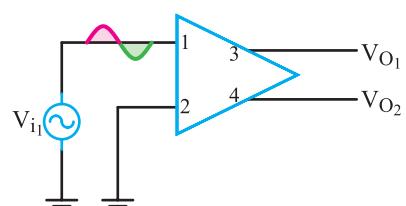


۶-۸-۸ در شکل ۶-۴۰ شکل موج های خروجی V_{O1} و V_{O2} را رسم کنید.



۶-۸-۹ کدام گزینه کاربرد مدار شکل ۶-۳۷ را به درستی

بیان می کند؟



شکل ۶-۳۷

۱- تقویت کننده توان

۲- حذف کننده پارازیت

۳- مقایسه کننده

۴- جدا کننده فاز

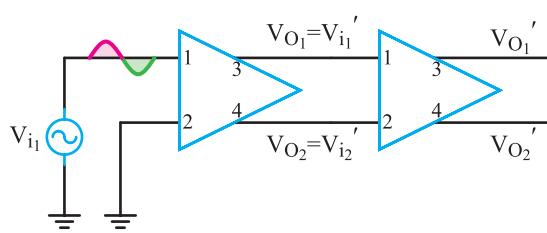
محاسباتی

۶-۸-۵ در یک تقویت کننده تفاضلی اگر بهره حالت تفاضلی 125% و بهره حالت سیگنال مشترک 25% باشد. CMRR را محاسبه کنید. بر حسب دسی بل چه قدر است؟

تشریحی و ترسیمی

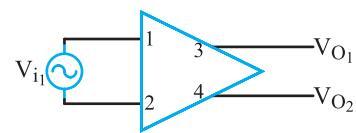
۶-۸-۶ در شکل ۶-۳۸ تقویت کننده تفاضلی در

۶_۴۲ در شکل ۶_۴۲ شکل موج های V_{O1} , V_{O2} را با توجه به سیگنال V_{i1} , V_{i2} رسم کنید.



شکل ۶_۴۲

۶_۴۱ در شکل ۶_۴۱ شکل موج های خروجی V_{O1} و V_{O2} را رسم کنید. تقویت کننده در چه حالتی به کار گرفته شده است؛ تفاضلی یا مُد مشترک؟



شکل ۶_۴۱